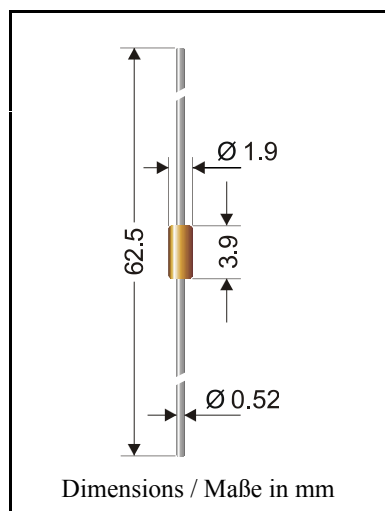


Bidirectional Si-Trigger-Diodes (DIAC)
Bidirektionale Si-Trigger-Dioden (DIAC)


Breakover voltage Durchbruchsspannung	28 ... 45 V
Peak pulse current Max. Triggerimpuls	± 2 A
Glass case Glasgehäuse	DO-35 SOD-27
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 16 siehe Seite 16

Maximum ratings
Grenzwerte

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 50$ °C	P_{tot}	150 mW ¹⁾
Peak pulse current (120 pulse repetition rate) Max. Triggerstrom (120 Impulse)	$t_p \leq 10$ μ s	I_{PM}	± 2 A ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-40 \dots +100$ °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	$-40 \dots +150$ °C

Characteristics
Kennwerte

Breakover voltage Durchbruchsspannung	$dV/dt = 10V/\mu s$	DB 3 DB 4	V_{BO} V_{BO}	28 ... 36 V 35 ... 45 V
Breakover current – Durchbruchstrom		$V = 98 \% V_{BO}$	I_{BO}	< 200 μ A
Asymmetry of breakover voltage Unsymmetrie der Durchbruchspannung		$ V_{(BO)F} - V_{(BO)R} $	ΔV_{BO}	< 3.8 V
Foldback voltage – Spannungs-Rücksprung $\Delta I = I_{BO}$ to/auf $I_F = 10$ mA	$dV/dt = 10V/\mu s$		$\Delta V_{F/R}$	> 5 V
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 60 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

